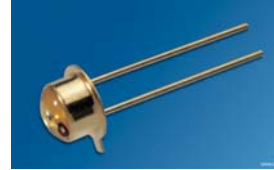


GaAlAs Infrared Emitter
GaAs-IR-Lumineszenzdiode
Version 1.0

SFH 483 E7800



Features:

- Fabricated in a liquid phase epitaxy process
- Anode is electrically connected to the case
- High reliability
- Matches all Si-Photodetectors
- Same package as BPX 63, BP 103, LD 242, SFH 464
- DIN humidity category in acc. with DIN 40 040 GQG

Applications

- Photointerrupters
- Sensor technology
- Light curtains

Notes

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471.

Besondere Merkmale:

- Hergestellt im Schmelzepitaxieverfahren
- Anode galvanisch mit dem Gehäuseboden verbunden
- Hohe Zuverlässigkeit
- Gute spektrale Anpassung an Si-Fotoempfänger
- Gehäusegleich mit BPX 63, BP 103, LD 242, SFH 464
- Anwendungsklasse nach DIN 40 040 GQC

Anwendungen

- Lichtschranken
- Sensorik
- Lichtgitter

Hinweise

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden.

Ordering Information

Bestellinformation

Type: Typ:	Radiant Intensity Strahlstärke $I_F = 100 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$ $I_e \text{ [mW/sr]}$	Ordering Code Bestellnummer
SFH 483 L/M E7800	2 (≥ 1)	Q62703Q4755

Note: measured at a solid angle of $\Omega = 0.01 \text{ sr}$

Anm.: gemessen bei einem Raumwinkel $\Omega = 0.01 \text{ sr}$

Maximum Ratings ($T_C = 25 \text{ }^\circ\text{C}$)

Grenzwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	T_{op} ; T_{stg}	-40 ... 80	$^\circ\text{C}$
Reverse voltage Sperrspannung	V_R	5	V
Forward current Durchlassstrom	I_F	200	mA
Surge current Stoßstrom ($t_p \leq 10 \text{ } \mu\text{s}$, $D = 0$)	I_{FSM}	2.5	A
Total power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	470	mW
Thermal resistance junction - ambient Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung	R_{thJA}	450	K / W
Thermal resistance junction - case Wärmewiderstand Sperrschicht - Gehäuse	R_{thJC}	160	K / W

Characteristics ($T_A = 25\text{ °C}$)**Kennwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge ($I_F = 100\text{ mA}$)	λ_{peak}	880	nm
Spectral bandwidth at 50% of I_{max} Spektrale Bandbreite bei 50% von I_{max} ($I_F = 100\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$)	$\Delta\lambda$	80	nm
Half angle Halbwinkel	φ	± 23	$^\circ$
Active chip area Aktive Chipfläche	A	0.16	mm ²
Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche	L x W	0.4 x 0.4	mm x mm
Distance chip surface to lens top Abstand Chipoberfläche bis Linsenscheitel	H	2.7 ... 2.9	mm
Rise and fall times of I_e (10% and 90% of $I_{e,\text{max}}$) Schaltzeiten von I_e (10% und 90% von $I_{e,\text{max}}$) ($I_F = 100\text{ mA}$, $R_L = 50\ \Omega$)	t_r / t_f	600 / 500	ns
Capacitance Kapazität ($V_R = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$)	C_0	25	pF
Forward voltage Durchlassspannung ($I_F = 100\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$)	V_F	1.5 (≤ 1.8)	V
Forward voltage Durchlassspannung ($I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 100\ \mu\text{s}$)	V_F	2.4 (≤ 3)	V
Reverse current Sperrstrom ($V_R = 5\text{ V}$)	I_R	0.01 (≤ 1)	μA
Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss ($I_F = 100\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$)	Φ_e	23	mW

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Temperature coefficient of I_e or Φ_e Temperaturkoeffizient von I_e bzw. Φ_e ($I_F = 100 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$)	TC_I	-0.5	% / K
Temperature coefficient of V_F Temperaturkoeffizient von V_F ($I_F = 100 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$)	TC_V	-2.5	mV / K
Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge ($I_F = 100 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$)	TC_λ	0.25	nm / K

Grouping ($T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$)**Gruppierung**

Group Gruppe	Min Radiant Intensity Min Strahlstärke $I_F = 100 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$ $I_{e, \text{min}}$ [mW / sr]	Max Radiant Intensity Max Strahlstärke $I_F = 100 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$ $I_{e, \text{max}}$ [mW / sr]
SFH 483-L E7800	1	2
SFH 483-M E7800	1.6	3.2

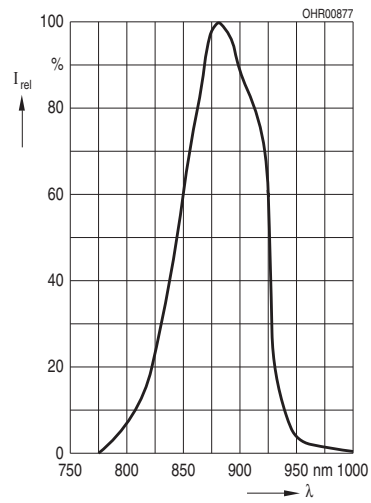
Note:

An aperture is used in front of the component for measurement of the radiant intensity and the half angle (diameter of the aperture: 1.1 mm; distance of aperture to case back side: 4.0 mm). This ensures that solely the radiation in axial direction emitting directly from the chip surface will be evaluated during measurement of the radiant intensity. Radiation reflected by the bottom plate (stray radiation) will not be evaluated. These reflections impair the projection of the chip surface by additional optics (e.g. long-range light reflection switches). In respect of the application of the component, these reflections are generally suppressed by apertures as well. This measuring procedure corresponding with the application provides more useful values. This aperture measurement is denoted by "E 7800" added to the type designation.

Die Messung der Strahlstärke und des Halbwinkels erfolgt mit einer Lochblende vor dem Bauteil (Durchmesser der Lochblende: 1,1 mm; Abstand Lochblende zu Gehäuserückseite: 4,0 mm). Dadurch wird sichergestellt, dass bei der Strahlstärkemessung nur diejenige Strahlung in Achsrichtung bewertet wird, die direkt von der Chipoberfläche austritt. Von der Bodenplatte reflektierte Strahlung (vagabundierende Strahlung) wird dagegen nicht bewertet. Diese Reflexionen sind besonders bei Abbildungen der Chipoberfläche über Zusatzoptiken störend (z. B. Lichtschranken großer Reichweite). In der Anwendung werden im allgemeinen diese Reflexionen ebenfalls durch Blenden unterdrückt. Durch dieses der Anwendung entsprechende Messverfahren ergibt sich für die Anwender eine besser verwertbare Größe. Diese Lochblendenmessung ist gekennzeichnet durch den Eintrag "E 7800", der an die Typenbezeichnung angehängt ist.

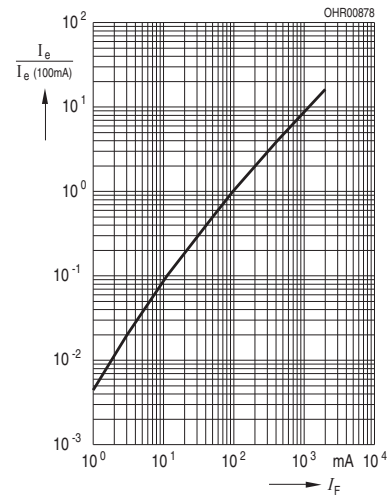
Relative Spectral Emission
Relative spektrale Emission

$I_{\text{rel}} = f(\lambda)$, $T_A = 25^\circ\text{C}$



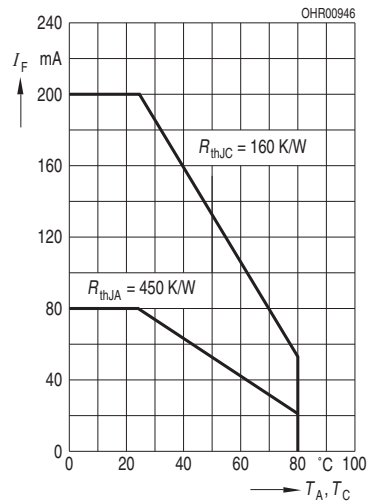
Radiant Intensity
Strahlstärke

$I_e / I_e(100 \text{ mA}) = f(I_F)$, single pulse, $t_p = 25 \mu\text{s}$,
 $T_A = 25^\circ\text{C}$



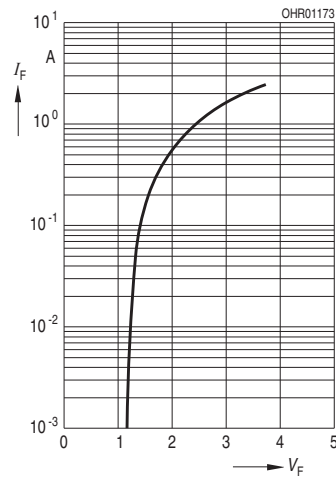
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom

$I_{F, max} = f(T_A)$



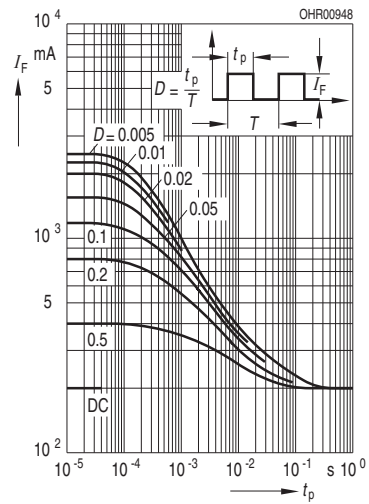
Forward Current
Durchlassstrom

$I_F = f(V_F)$, single pulse, $t_p = 100 \mu s$, $T_A = 25^\circ C$



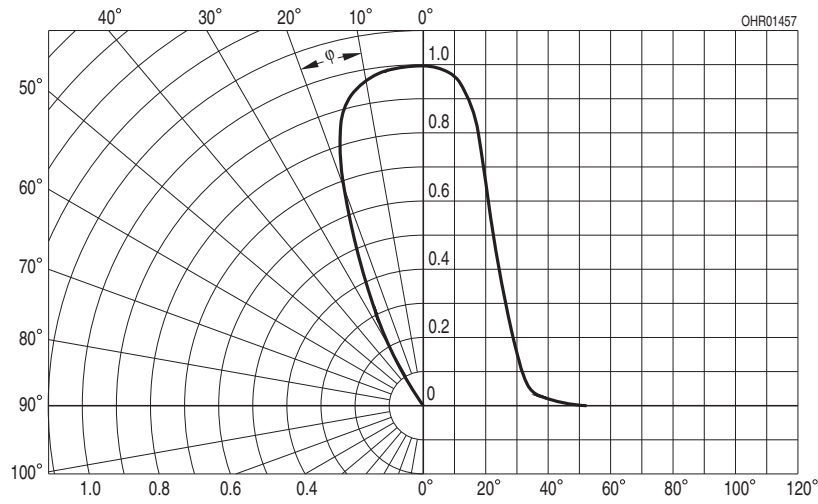
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit

$I_F = f(t_p)$, $T_A = 25^\circ C$, duty cycle $D =$ parameter

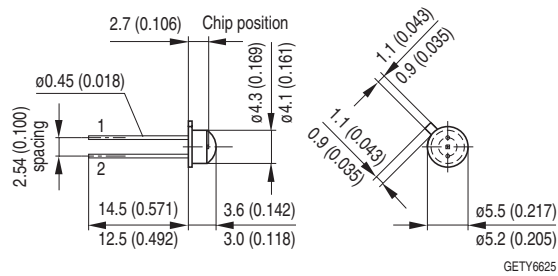


Radiation Characteristics
Abstrahlcharakteristik

$I_{rel} = f(\varphi)$



Package Outline
Maßzeichnung



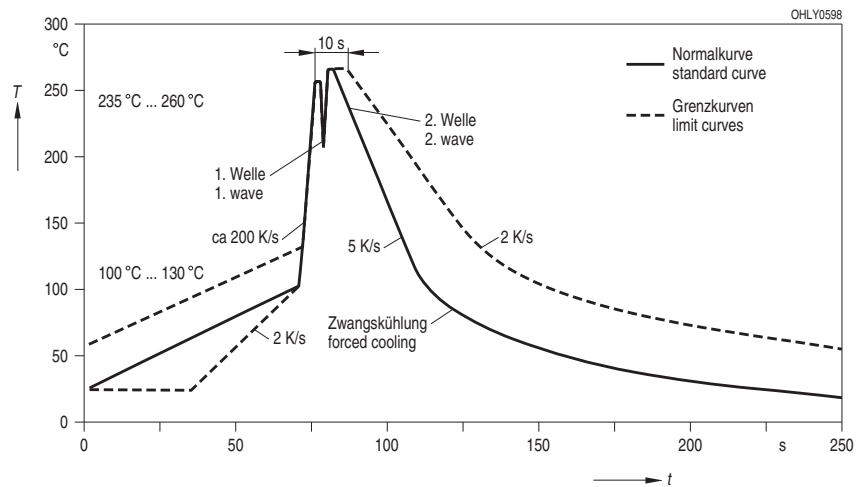
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

**Pinning
Anschlussbelegung**

Pin Anschluss	Description Beschreibung
1	Cathode / Kathode
2	Anode / Anode

Package Metal Can (TO-18), hermetically sealed, Epoxy, transparent

Gehäuse Metall Gehäuse (TO-18), hermetisch dicht, Harz, durchsichtig

**TTW Soldering
Wellenlöten (TTW)**
 IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW


Disclaimer**Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer**Bitte beachten!**

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

HS and China RoHS compliant product



符合欧盟 RoHS 指令的要求；
国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。